








	<h2 style="color: #E67E22;">FQB5N90TM</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	FQB5N90TM
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 900V 5.4A D2PAK
Datenblätter:	 FQB5N90TM.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 1723 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	FQB5N90TM
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 900V 5.4A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	1723 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	12 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 900V 5.4A (Tc) 3.13W (Ta), 158W (Tc)
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK (TO-263AB)
Verlustleistung (max)	3.13W (Ta), 158W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	900V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5.4A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.3 Ohm @ 2.7A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	40nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1550pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Cut Tape (CT)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FQB5N90TMCT

FQB5N90TM ist neu im Original, Suche FQB5N90TM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQB5N90TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQB5N90TM: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQB5N80TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 4.8A D2PAK</p>	 <p>FQB5N90TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 5.4A D2PAK</p>	 <p>FQB5P20TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 200V 4.8A D2PAK</p>	 <p>FQB5P10 F FQB5P10 F</p>
 <p>FQB5P10TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 4.5A D2PAK</p>	 <p>FQB5N60TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 5A D2PAK</p>	 <p>FQB5P20TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 200V 4.8A D2PAK</p>	 <p>FQB5N80TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 4.8A D2PAK</p>

heiße Teile

Mehr

⚙ FQB50N03	↔ FQB50N06	⇒ FQB50N06C	D FQB50N06L	↔ FQB50N06LTM
↔ FQB50N06LTM	⚙ FQB50N06M	D FQB50N06TM	⇒ FQB50N06TM	↔ FQB50N06TM-NL
⚙ FQB55N06TM	↔ FQB55N06TM	⚙ FQB55N10	↔ FQB55N10TM	↔ FQB55N10TM
D FQB5N20L	⚙ FQB5N30TM	↔ FQB5N30TM	⚙ FQB5N50C	↔ FQB5N50CF
⇒ FQB5N50CTM	↔ FQB5N50CTM	⚙ FQB5N60CTM	↔ FQB5N60CTM	↔ FQB5N90TM
↔ FQB5P10TM	⇒ FQB5P10TM	D FQB630TM	⚙ FQB630TM	↔ FQB65N06
⚙ FQB65N06TM	D FQB65N06TM	⇒ FQB6N40C	↔ FQB6N40CF	↔ FQB6N40CTM
↔ FQB6N40CTM	⚙ FQB6N50TM	↔ FQB6N50TM	⇒ FQB6N60C	↔ FQB6N60CTM
⚙ FQB6N60CTM	↔ FQB6N60TM	⚙ FQB6N60TM	D FQB6N70TM	↔ FQB6N70TM
↔ FQB6N90TM	⚙ FQB6N90TM_AM002	↔ FQB6N90TM_AM002	⚙ FQB7042FB	↔ FQB7045FB

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

